



PRESSEINFORMATION

Infineon erreicht nächsten Meilenstein auf der Roadmap für 200-mm-Siliziumkarbid (SiC): Produktauslieferung an Kunden startet

- Infineon liefert erste Siliziumkarbid-Produkte an Kunden aus, die auf der fortschrittlichen 200 Millimeter SiC-Technologie basieren
- Die in Villach, Österreich, gefertigten Produkte bieten erstklassige SiC-Power-Technologie für Hochspannungsanwendungen
- Mit der 200-mm-SiC-Produktion stärkt Infineon seine Technologieführerschaft im gesamten Spektrum der Leistungshalbleiter

München, 13. Februar 2025 – Die Infineon Technologies AG hat bei der Umsetzung der 200-mm-Siliziumkarbid (SiC)-Strategie entscheidende Fortschritte erzielt. Das Unternehmen wird bereits im ersten Quartal 2025 die ersten Produkte, die auf der fortschrittlichen 200-mm-SiC-Technologie basieren, an Kunden ausliefern. Die in Villach, Österreich, gefertigten Produkte bieten erstklassige SiC-Power-Technologie für Hochspannungsanwendungen, darunter erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, Schnellladestationen und Züge. Auch die Umstellung des Infineon-Produktionsstandorts in Kulim, Malaysia, von 150-mm-Wafern auf die größeren und effizienteren 200-mm-Wafer verläuft nach Plan. Das neu errichtete Modul 3 wird die Hochvolumenfertigung im Einklang mit den Marktbedingungen aufnehmen.

„Die Umsetzung unserer SiC-Fertigung schreitet wie geplant voran und wir sind stolz auf die ersten Kundenauslieferungen“, sagt Dr. Rutger Wijburg, Chief Operations Officer von Infineon. „Durch das schrittweise Hochfahren der SiC-Produktion in Villach und Kulim verbessern wir die Kosteneffizienz und sichern weiterhin die Produktqualität. Gleichzeitig erreichen wir, dass die Produktionskapazitäten die Nachfrage nach SiC-Leistungshalbleitern decken.“

SiC-basierte Leistungshalbleiter haben Hochleistungsanwendungen revolutioniert. Sie können Strom noch effizienter schalten, weisen eine hohe Zuverlässigkeit und Robustheit unter extremen Bedingungen auf und ermöglichen noch kleinere Designs. Mit den SiC-Produkten von Infineon können Kunden energieeffiziente Lösungen für Elektrofahrzeuge, Schnellladestationen und Züge sowie für erneuerbare Energiesysteme und KI-Rechenzentren entwickeln. Die Auslieferung der ersten SiC-Produkte, die auf der 200-mm-Wafer-Technologie basieren, ist ein wichtiger Schritt auf der SiC-Roadmap von Infineon, mit

dem Ziel, Kunden ein umfassendes Portfolio an Hochleistungshalbleitern zu bieten, die grüne Energie ermöglichen und zur CO₂-Reduktion beitragen.

Als „Infineon One Virtual Fab“ für hochinnovative Wide-Bandgap-Technologien nutzen die Infineon-Produktionsstandorte in Villach und Kulim gemeinsame Technologien und Prozesse, die einen schnellen Ramp-up sowie einen reibungslosen und hocheffizienten Betrieb in der SiC- und Galliumnitrid (GaN)-Fertigung ermöglichen. Die 200-mm-SiC-Fertigung ist ein weiterer Baustein in der Erfolgsgeschichte von Infineon als Anbieter von branchenführenden Halbleiterlösungen für Power Systems. Sie stärkt die Technologieführerschaft des Unternehmens im gesamten Spektrum der Leistungshalbleiter von Silizium bis hin zu Siliziumkarbid und Galliumnitrid.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Follow us: [X](#) - [Facebook](#) - [LinkedIn](#)